

CentralTM Semiconductor Corp.

145 Adams Avenue, Hauppauge, NY 11788 USA
Tel: (631) 435-1110 • Fax: (631) 435-1824

Manufacturers of World Class Discrete Semiconductors

1N3600
1N4150

SILICON SWITCHING DIODE

JEDEC DO-35 CASE

DESCRIPTION

The CENTRAL SEMICONDUCTOR 1N3600, 1N4150, silicon planar epitaxial diode is characterized by its miniature size, ultra fast switching speed, low capacitance, low leakage, and high conductance. Accordingly, it is ideally suited for applications such as pulse applications, avalanche circuits, core drivers, and for any critical circuit requiring high conductance at power dissipation without sacrificing fast recovery capability. (Both devices have identical electrical and mechanical specifications).

MAXIMUM RATINGS ($T_A=25^\circ\text{C}$)

	SYMBOL		UNIT
Peak Working Inverse Voltage	V_{RWM}	50	V
Average Forward Current	I_O	200	mA
Forward Steady State Current	I_F	400	mA
Recurrent Peak Forward Current	i_f	600	mA
Peak Forward Surge Current (1.0s Pulse)	I_{FSM}	1.0	A
Peak Forward Surge Current (1.0us Pulse)	I_{FSM}	4.0	A
Power Dissipation	P_D	500	mW
Operating and Storage			
Junction Temperature	T_J, T_{STG}	-65 to +200	$^\circ\text{C}$

ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_A=25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)

SYMBOL	TEST CONDITIONS	MIN	MAX	UNIT
I_R	V_R =Rated V_{RWM}		100	nA
I_R	V_R =Rated V_{RWM} , $T_A=150^\circ\text{C}$		100	μA
BV_R	$I_R=5.0\mu\text{A}$	75		V
V_F	$I_F=1.0\text{mA}$	0.54	0.62	V
V_F	$I_F=10\text{mA}$	0.66	0.74	V
V_F	$I_F=50\text{mA}$	0.76	0.86	V
V_F	$I_F=100\text{mA}$	0.82	0.92	V
V_F	$I_F=200\text{mA}$	0.87	1.0	V
C	$V_R=0\text{V}$, $f=1.0\text{MHz}$		2.5	pF
t_{fr}	$V_{fr}=1.0\text{V}$, $I_f=200\text{mA}$, $t_r=0.4\text{ns}$		10	ns
t_{rr}	$I_f=I_r=10\text{mA}$ to 200mA , $R_L=100\Omega$		4.0	ns
t_{rr}	$I_f=I_r=200\text{mA}$ to 400mA , $R_L=100\Omega$		6.0	ns

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Central Semiconductor:](#)

[1N4150](#) [1N3600](#) [1N3600 TR](#)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.